

## 1. 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings Tc=25°C

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~175	°C
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		-55~175	°C
トレン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V <sub>DSS</sub>		60	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V <sub>GSS</sub>		±20	V
トレン電流 Continuous Drain Current	I <sub>D</sub>		120	A
ビーグ Peak	I <sub>DP</sub>	Pulse width=10 μs, duty=1/100	480	
ソース電流 Continuous Source Current	I <sub>S</sub>		120	
全損失 Total Power Dissipation	PT	フイン付き	217	W
		*1	TBD	W
		*2	TBD	W
単発アーランシェ電流 Single Avalanche Current	I <sub>AS</sub>	Starting Tch=25°C, Tch≤150°C	48	A
単発アーランシェエネルギー Single Avalanche Energy	E <sub>AS</sub>	Starting Tch=25°C, Tch≤150°C	252	mJ

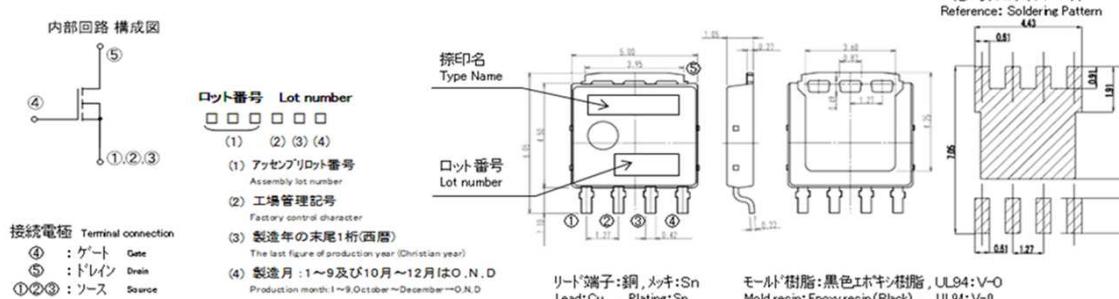
## 2. 電気的・熱的特性 Electrical Characteristics Tc=25°C

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			Min.	Typ.	Max.	
トレン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V(BR)DSS	I <sub>D</sub> = 1 mA, V <sub>GS</sub> = 0 V	60			V
トレン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	IDSS	V <sub>DS</sub> = 60 V, V <sub>GS</sub> = 0 V			1	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	IGSS	V <sub>GS(±)</sub> = ±20 V, V <sub>DS</sub> = 0 V			±0.1	μA
順伝導コンダクタンス (※) Forward Transconductance	g <sub>f</sub> s	I <sub>D</sub> = 60 A, V <sub>DS</sub> = 10 V	27			S
トレン・ソース間オン抵抗 (※) Static Drain-Source On-state Resistance	RDS(ON)	I <sub>D</sub> = 60 A, V <sub>GS</sub> = 10 V		1.83	2.3	mΩ
ゲートしきい値電圧 (※) Gate Threshold Voltage	V <sub>TH</sub>	I <sub>D</sub> = 1 mA, V <sub>DS</sub> = 10 V	2.0	3.0	4.0	V
ソース・トレン間ダイオード順電圧 (※) Source-Drain Diode Forward Voltage	V <sub>SD</sub>	I <sub>S</sub> = 120 A, V <sub>GS</sub> = 0 V			1.2	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-c)</sub>	接合部・ケース間 Junction to Case			0.69	°C/W
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-a)</sub>	接合部・周囲間 Junction to ambient *1			TBD	°C/W
熱抵抗 Thermal Resistance	R <sub>th(j-a)</sub>	接合部・周囲間 Junction to ambient *2			TBD	°C/W
ゲート全電荷量 Total Gate Charge	Q <sub>g</sub>	V <sub>DD</sub> = 48 V, V <sub>GS</sub> = 10 V		70		nC
ゲートソース電荷量 Gate to Source Charge	Q <sub>gs</sub>	I <sub>D</sub> = 120 A		21		
ゲートトレン電荷量 Gate to Drain Charge	Q <sub>gd</sub>			21		
入力容量 Input Capacitance	C <sub>iss</sub>	V <sub>DS</sub> = 25 V, V <sub>GS</sub> = 0 V		4950		pF
出力容量 Output Capacitance	C <sub>oss</sub>	f= 1 MHz		2079		
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C <sub>rss</sub>			75		
ターンオン遅延時間 Turn-on Delay Time	td(on)	I <sub>D</sub> = 60 A, V <sub>DD</sub> = 30 V		11		ns
上昇時間 Rise Time	tr	R <sub>G</sub> = 0 Ω, R <sub>L</sub> = 0.50 Ω		43		
ターンオフ遅延時間 Turn-off Delay Time	td(off)	V <sub>GS(+)</sub> = 10 V, V <sub>GS(-)</sub> = 0 V		38		
下降時間 Fall Time	tf			17		
ダイオード逆回復時間 Diode Reverse Recovery Time	t <sub>rr</sub>	I <sub>F</sub> = 120 A, V <sub>GS</sub> = 0 V		67		ns
ダイオード逆回復電荷量 Diode Reverse Recovery Charge	Q <sub>rr</sub>	di/dt= 100 A/μs		92		nC

(※)Pulsed

\*1 ガラスエポキシ基板実装 1インチ角基板 銅箔パターン総面積:585.13mm<sup>2</sup> Measured on the 1 inch2 glass epoxy substrate pattern area :585.13mm<sup>2</sup>\*2 ガラスエポキシ基板実装 1インチ角基板 銅箔パターン総面積:69.29mm<sup>2</sup> Measured on the 1 inch2 glass epoxy substrate pattern area :69.29mm<sup>2</sup>

## 3. 外形・寸法 Outline Dimensions



・本仕様書に記載されている内容は、製品改良等の為にお断り無しに変更することがありますのでご了承下さい。

・Please acknowledge that the content that has been described to this specification changes for an improvement without notice.

新電元工業株式会社 電子デバイス事業本部 電子デバイス事業部 第二開発部 Shindengen Electric MFG. CO., LTD. JAPAN Devices Development Dept.2. Electronic Device Div. Electronic Device Div. Group			客先名: Customer's:		
承認 Approval			設計 design		
品名: Type name:			(仮)P120LF6GMK		
図版: Specification No.:			版 Edit. 頁 Page		
三川 23/08/18 雅人	竹本 '23/08/03 剛太郎	大谷 2023.7.25 欣也	3SK-220027	-3	1/1